Renbo

# 宇宙開発に貢献する放射線利用 —宇宙用太陽電池の放射線劣化とその予測—



近年,宇宙機の電力要求の高まりに伴い,光 電変換効率が30%に迫る3接合太陽電池が開 発され<sup>1,2)</sup>,既に人工衛星などに使用されてい る。この太陽電池は,トップセル(受光表面側 太陽電池)にInGaP,ミドルセル(中間太陽電 池)にGaAs,そしてボトムセル(裏面側太陽 電池)にGeを材料として用いた3種類の太陽 電池が積層された構造となっている。これらの 構成太陽電池をサブセルと呼ぶ。

人工衛星など宇宙機に用いられる太陽電池 は、10年程度前までは変換効率が約17%の単 結晶 Si 太陽電池が主流であった。この太陽電 池は pn 接合が1つ(単一接合太陽電池)であ り、その放射線劣化における振舞いは比較的単 純である。さらに、開発・実用になってから歴 史があるため、放射線劣化もよく研究されてい る。したがって、実際の宇宙空間における劣化 の予測方法は既に確立されている。一方、3接 合太陽電池は開発され実用に供されたのが比較 的最近で、かつその構造から放射線劣化の振舞 いが複雑である。



**今泉 充** *Imaizumi Mitsuru* ((独)宇宙航空研究開発機構)

ここでは,宇宙用太陽電池の要求性能から放 射線劣化特性及び劣化予測法について,劣化デ ータを交えながら紹介する。

## 2 宇宙用太陽電池

現在用いられている太陽電池パネルの断片の 外観を図1に、またその典型的な断面構造の模 式図を図2に示す。太陽電池の表面には放射線 の遮蔽材として厚さ100~150 µm 程度のカバ



図1 太陽電池パネルの断片 (試験用クーポンパネル)

ーガラスと呼ばれるガラス板 がシリコーン系の透明接着剤 にて貼り付けられる。そして これが、アルミニウム薄板に よるハニカム構造の表裏両面 に強化炭素繊維(CFRP)の 布を樹脂によって板状に成型 したものを貼り付けたサブス トレートと呼ばれるパネル (厚さ10~25 mm)に、絶縁 用のポリイミドフィルムを挟



図2 模式的に示した太陽電池パネルの典型的な断面構造

んで,熱伝導性の高い別の種類のシリコーン系 接着剤(赤色)によって接着されている。

宇宙空間には、広いエネルギー分布を持った 放射線粒子が飛び交っている。そのほとんどは カバーガラスによって遮蔽されるため、太陽電 池の劣化には寄与しない。宇宙放射線粒子の中 で太陽電池に損傷を与えて出力を劣化させるの は、 飛来数がほかの粒子と比較して桁違いに多 くかつ透過力が大きい高エネルギーの電子及び 陽子である。放射線による劣化前の状態(ある いはそのときの出力)すなわち初期状態(初期 値) を BOL (Beginning of Life) と呼び、また 放射線による劣化後の状態(あるいはそのとき の出力)をEOL(End of Life)という。また. EOL における出力を BOL における出力で除し た値を保存率という。よって、保存率が高いこ とが,耐放射線性が高いということを意味 する。

BOL 出力と耐放射線性の両者が高いことが 宇宙用太陽電池に要求される基本的な性能であ る。宇宙用太陽電池における効率は,EOL に おける効率が高いことが重要であって,BOL において効率が高いことはほとんど意味がな い。当然ながら太陽電池パネルはその宇宙機の ミッション期間中の予測放射線被ばく量から見 積もられる劣化後すなわちEOL における発生 電力で設計される。一方で,BOL からの劣化 によって失われる電力分は基本的には余剰電力 である。耐放射線性が低い太陽電池を使用する



図3 宇宙空間の模擬太陽光 (AM0)を照射したときの 3 接合太陽電池の代表的な電流-電圧特性

と太陽電池パネルのサイズが大きくなるばかり か,余剰電力の消費対策を施さなければならな い。太陽電池の耐放射線性が高く(=変化率が 小さく)EOL効率が高ければ,宇宙機の電力 要求値に対し太陽電池パネルの必要面積を少な く,すなわち宇宙機を小さく,軽くすることが できるという大きなメリットが出せる。

図3に示したのは、宇宙用3接合太陽電池 に、宇宙空間の模擬太陽スペクトル光(AM0 という)を照射したときの代表的な電流-電圧 特性である。太陽電池の両端を開放したときの 電圧出力(開放電圧:Voc)は約2.65 V,両端 を短絡したときの電流出力(短絡電流:Isc, 多くの場合単位面積当たりの値に規格化する) は約 17 mA/cm<sup>2</sup>,そして電力(各点の電流と電 圧の積)が最大を取る点(Pmax)から求めた 変換効率(Pmax を宇宙空間の太陽光強度 136.7 mW/cm<sup>2</sup>で除する)は 27%と極めて高い。

#### 3 太陽電池の放射線劣化

宇宙環境において太陽電池が受ける放射線に よる主な損傷は、放射線によって太陽電池材料 である単結晶半導体中の構成原子が、放射線粒 子が与えるエネルギーによって格子点からはじ き出されることによる(放射線粒子の非イオン 化エネルギー損失)。この結果,格子欠陥であ る格子間原子及び原子空孔が形成される。この 格子間原子と原子空孔の対はフレンケル対と呼 ばれ、放射線損傷による1次欠陥として扱われ る。このフレンケル対型の結晶欠陥が直接、な いしはその後幾段かの欠陥反応(ほかの型の結 晶欠陥への変化)を経た後に形成される結晶欠 陥(多くの場合複合欠陥)が少数キャリアの再 結合中心を形成し、少数キャリア寿命が低下し て結果的に出力が低下する。また多くの場合, 欠陥には多数キャリア(正孔)捕獲準位として 振舞うものも生成され、特に被ばく量が大きく なるとp型層すなわち光吸収層のキャリア濃度 が低下して高抵抗化し, pn 接合が消滅して太 陽電池として動作しなくなる<sup>3)</sup>。図4に、宇宙 用 Si 太陽電池の, 放射線照射前後での光照射 下電流-電圧特性を示す。

前述のように、宇宙空間で太陽電池に損傷・ 劣化を与える放射粒子は電子と陽子である。こ れらには、太陽から飛来するもの(太陽風)、 地球磁場に捉えられているもの(捕捉宇宙線), ないしはその他の天体から飛来するもの(銀河 宇宙線)の3種類があり、それらの単位時間当 たりの飛来密度(フラックス)は、宇宙空間に おける位置、すなわち宇宙機の軌道によって異 なる。その他の粒子(イオン)は、実際の宇宙 空間ではそのフラックスが電子、陽子と比較す ると極端に少ないこと、及びカバーガラスで遮



図4 宇宙用 Si 太陽電池の放射線照射前後での光照射 下電流-電圧特性

蔽されることから,通常は劣化要因として考慮 しなくてよい。

宇宙用 Si 太陽電池の厚さが 100 µm ないし 50 µm と薄いのは、この放射線被ばくによる拡 散長の低下の影響を小さくし、耐放射線性を高 めるためである。薄くした結果、裏面側に光反 射層を形成しても太陽光の吸収が不十分となる ため、初期変換効率は地上用の単結晶 Si 太陽 電池(20%程度以上)と比較して低くなってい る。一方、直接遷移型 II-V族化合物は吸収係 数が大きいため光吸収層の厚さが Si 太陽電池 と比較して薄くてよく、拡散長の低下の影響が 出にくい。加えて、劣化は生じるものの、それ が室温程度でもある程度有意に回復し(その程 度は材料による)その速度も劣化の進行と比較 して十分早い。これが II-V族化合物太陽電池 が耐放射線性に優れる理由の1つである。

ある3接合太陽電池に対し,陽子線を照射量 (フルエンス; $\phi$ )一定( $\phi$ =1×10<sup>12</sup> cm<sup>-2</sup>)で エネルギーを変化させて照射すると,Voc, Isc,及びPmaxの保存率は図5のようになっ た<sup>4)</sup>。陽子のエネルギーが150 keVのとき各パ ラメータの保存率が最小となっている。モンテ カルロシミュレーションによれば、このエネル ギーの陽子はGaAsミドルセル内で停止する。 従って、この結果は3つのサブセルの中でミド ルセルが最も耐放射線性が低いことを示してい



 図5 照射量を一定(1×10<sup>12</sup> cm<sup>-2</sup>)としたときの 太陽電池出力パラメータ保存率の陽子線エ ネルギー依存性

る<sup>5)</sup>。なお,この傾向はほぼ全ての3接合太陽 電池においてみられる。

### 4 放射線劣化の予測

太陽電池パドルの電力出力はそのミッション 期間中の予測放射線被ばく量から見積もられる EOLにおける発生電力で設計される。そのた め,被ばく量の予測方法,そして被ばく量から の太陽電池劣化量の予測方法は宇宙機の設計に おいて欠かせない重要な技術である。

宇宙空間に存在する電子,陽子のエネルギー は様々であり,そのフラックス(単位時間当た りの飛来数)とエネルギーの関係は,一般的に は低エネルギーほど大きいが,そのスペクトル 形状は宇宙空間の位置に依存する。また,放射 線粒子は様々な方向から飛来する。一方,劣化 予測のための劣化データ取得は地上で加速器を 用いて行うため,エネルギーは基本的に単一で あり,また入射方向も1方向である。そのため 劣化予測には補正が必要である。また,図2に 示したように,実際には太陽電池には放射線遮 蔽材としてカバーガラスが貼り付けられる。こ のガラス及び裏面側のサブストレートなどの遮 蔽効果の考慮も必要である。加えて,宇宙空間 では電子,陽子の飛来(太陽電池への入射)方 向は全球面に分布している。劣化予測では当然 これらの効果を考慮した計算を行うが,ここで は説明を単純化するためにそれら補正に関して は触れない。

(1) 劣化予測の準備

劣化予測に必要なデータは大きく分けて2 つ, ①電子, 陽子それぞれに対する劣化量のエ ネルギー依存性と②電子と陽子の劣化の比であ る。これらの求め方を以下に説明する。

耐放射線性を求める基本は保存率のフルエン ス依存性である。これを一般的に劣化曲線と呼 んでいる。まずこの劣化曲線を,陽子ないし電 子のエネルギーをパラメータとして地上照射試 験を実施して取得する。宇宙空間には広いエネ ルギー範囲の電子,陽子が存在するが,実験で 取得するのは実際に太陽電池の劣化に寄与する 数 10 keV~10 MeV 程度の範囲である。各エネ ルギーで得られた実験点から次式で示す経験式 を用いてフィッティング曲線を得る。

 $X/X_0 = 1 - A \log (1 + \phi/\phi_0)$  (1)

ここで、X:劣化後の太陽電池特性値 (Voc や Isc など)、 $X_0$ :劣化前の太陽電池特性値,  $\phi$ :フルエンス、A、 $\phi_0$ :フィッティング係数 である。

このデータ及びフィッティング曲線から,一 定の劣化(保存率)を与えるフルエンスを各エ ネルギーにおいて求める。このフルエンスのう ち,陽子の場合は10 MeV,電子の場合は1 MeVの値を基準として各エネルギーにおける 値で除する。この値を相対損傷係数;RDC (Relative Damage Coefficient)と呼び,基準エ ネルギー粒子(1 MeV電子,10 MeV 陽子)に 対して太陽電池特性値に損傷を与える度合いの 指標として扱う。例えば RDC が10 のとき, そのエネルギーの電子/陽子は1 MeV電子/10 MeV 陽子の10 倍の損傷を与える能力がある (10 分の1 の照射量で同じ劣化を与える)とい う意味である。

次に、図6において10 MeV 陽子と1 MeV



図 6 放射粒子のエネルギーを変えて求めた 3 接合太陽電池 の劣化曲線(陽子線,最大電力 Pmax の例)



図7 3 接合太陽電池の陽子と電子に対する 相対損傷係数

電子の劣化曲線から,先の相対損傷係 数を求めたときに用いた保存率を与え るフルエンスの比を求める。言い換え れば,10 MeV 陽子の1 MeV 電子に対 する RDC を求める。この値には特別 な名称がないが,ここでは変換係数と 呼ぶことにする。

以上が劣化予測のために必要な準備 である。

(2) 劣化予測

ある人工衛星による宇宙ミッション を計画すると,その実現に必要な宇宙 空間での軌道が決まる。一方で,宇宙 空間のある位置における放射線環境

は、人工衛星などによる過去の測定デ ータに基づいた環境計算プログラムによって求 めることができる。このプログラムを用いてそ の軌道における電子、陽子のフラックスのエネ ルギー分布スペクトルを得る。通常そのスペク トルは時刻によって変動するので、計画されて いるミッション期間の積分値を求めなければい けない。さらに、太陽フレアなどの"異常"環 境も確率によって考慮に入れる。こうして、そ の人工衛星がミッション期間中に浴びる電子、 陽子の総数のエネルギー分布を得る。

次に、この分布図に対し、電子、陽子それぞ れのRDCを乗ずる。これを全エネルギー範囲 にわたって積分すれば、その軌道とミッション 期間の電子ならば1 MeV 相当のフルエンス、 陽子ならば10 MeV 相当のフルエンスが得られ る。これを等価フルエンスと呼ぶ。さらに、換 算係数を用いて等価10 MeV 陽子フルエンスを 1 MeV 電子のフルエンスに変換し、電子の等 価1 MeV 電子フルエンスに加える。こうして、 その人工衛星の総等価1 MeV 電子フルエンス が得られる。今度は1 MeV 電子フルエンス が得られる。ったは1 MeV 電子による太陽電 池の劣化曲線に対して、この総等価1 MeV 電 子フルエンスを横軸に当てはめてそのときの保 存率を求める。こうして得られたのが目的の、 その人工衛星の太陽電池がミッション期間中に 劣化するであろう量/率の予測値である。

(3) 新しい予測法

以上述べた方法は米国のジェット推進研究所 において開発・確立された方法である<sup>6)</sup>。しか し、この方法では電子、陽子のエネルギーを変 えて数多くの放射線照射試験を実施しなければ ならない。そこで米国海軍研究所を中心として 開発されたのが変位損傷入射量;DDD (Displacement Damage Dose) 法である。紙面の制限 により詳細な説明はほかの機会に譲るとする が.この方法ではあらかじめ太陽電池の半導体 材料の種類に応じて各エネルギーの電子, 陽子 が与える損傷の度合いを表す値である NIEL (Non Ionized Energy Loss) 値を求めておき, 実 際の太陽電池に対する照射試験は電子, 陽子で それぞれ最低1種類(実際には確認のため2種 類程度)のエネルギーにて行う。この結果を元 に横軸に NIEL 値とフルエンスの積(=DDD) を,縦軸に保存率を取り劣化曲線を得る。実際 の劣化予測では、前述したミッション期間中の 各エネルギーの電子、陽子の総飛来数(フルエ ンス)と、それらの NIEL 値から総 DDD 値を 求め、劣化曲線に当てはめて劣化量を予測す る。現在,この方法を3接合太陽電池に適用す べく、研究を進めている(図7)。

# **5** まとめ

宇宙用太陽電池である,高効率3接合太陽電 池について,その要求性能と特性を説明した。 また,宇宙用太陽電池の放射線劣化とその予測 技術について,放射線劣化データを示しながら 解説した。今後,新たな高性能・高機能太陽電 池が開発されると,それに合わせてまた新たな 劣化予測手法や技術,さらにはここでは触れな かったが,劣化メカニズムの解明のための研究 が必要になるであろう。それには,放射線利用 技術の更なる進展が期待される。

#### 参考文献

- Stan, M.A., *et al.*, "The Production of >28% Efficient Triple-Junction Space Solar Cells at Emcore Photovoltaics", *Proc. 1st World Conf. Photovoltaic Energy Conversion*, CD: 3P–B5–03 (2003)
- Granata, J.E., *et al.*, "Next Generation GaInP<sub>2</sub>/ GaAs/Ge Solar Cells: Cell Design and Qualification Status", *Proc. 1st World Cof. Photovoltaic Energy Conversion*, CD: 3P–B5–01 (2003)
- Yamaguchi, M., et al., Appl. Phys. Lett., 70(12), 1566–1568 (1997)
- Imaizumi, M., et al., Proc. 29th IEEE Photovol. Specialists Conf., pp.990–993 (2002)
- 5) Imaizumi, M., et al., Proc. 1st World Conf. Photovol. Ener. Conv., CD: 3P-B5-03 (2003)
- Anspaugh, B.E., et al., "Soalr Cell Radiation Handbook", JPL Publication 82–69, Chap.4.